

- лучевой эпитаксией
10.45-11.00 **Ляпунов Д.В.** (НИ ТГУ, Томск)
Электрофизические характеристики МЛЭ пленок КРТ после имплантации ионов As⁺

11.00-11.20 Перерыв на кофе

Председатели: К.А. Кузнецов, А. Уразбеков

- 11.20-11.35 **Воеводин В.И.** (НИ ТГУ, Томск)
Образование собственного оксида на поверхности (1000) GaSe
11.35-11.50 **Конфедератова К.А.** (ИФП СО РАН, НГУ, Новосибирск)
Формирование GaN квантовых точек низкой плотности на поверхности (0001)AlN в аммиачной МЛЭ
11.50-12.05 **Юданова Е.С.** (ИФП СО РАН, Новосибирск)
Рост и изучение свойств кристаллов органо-минерального перовскита CH₃NH₃RbI₃
12.05-12.20 **Сущков А.А., Шенгуров В.Т., Денисов С.А., Чалков В.Ю., Павлов Д.А.** (ННГУ, Нижний Новгород)
Гетеронаноструктуры Ge/Si и GaAs/Ge: исследование поперечного среза
12.20-12.35 **Титаев Д.Н., Титаева Е.К., Федосеев В.Б.** (ННГУ, Нижний Новгород)
Пересыщение в системах малого объема
12.35-12.50 **Титаева Е.К., Титаев Д.Н., Большакова А.В.** (ННГУ, Нижний Новгород)
Рост нитевидных кристаллов в метасиликатном геле в системах микронного размера

19 мая (четверг)

Вечернее заседание

Секция 1. Физика полупроводников и диэлектриков

Председатели: А. Уразбеков, А.М. Богатырева

- 14.00-14.15 **Зятиков И.А., Шульга А.Ю.** (НИ ТГУ, Томск)
Переходная электролюминесценция в органических светодиодах
14.15-14.30 **Безпальный А.Д., Верхотуров А.О., Шандаров В.М.** (ТУСУР, Томск)
Поточечное формирование волноводных элементов в фоторефрактивной поверхностной области ниобата лития оптическим методом
14.30-14.45 **Важинская К.С., Важинский О.Т., Паргачёв И.А.** (ТУСУР, ООО «Кристалл Т», Томск)
Исследование влияния температуры на мощность излучения второй гармоники в высокоомном кристалле РКТР
14.45-15.00 **Празян Т.Л.** (КемГУ, Кемерово)
Исследование методами теории функционала плотности электронной